

科学研究費採択実績(過去5年分)

○平成31年度

単位:千円

研究種目	新規/継続	学科	代表者名		研究課題名	研究期間	直接経費 (間接経費)
基盤研究(C)	新規	機械工学科	教授	中島 賢治	オンチップ微小液滴電気穿孔プロセスの数値解析と現象メカニズムの解明	H31-H33	2,000 (600)
基盤研究(C)	新規	物質工学科	准教授	田中 泰彦	ガスの収納と放出を可能とする分子膜被覆による機能化ファインバブルの創製	H31-H33	1,800 (540)
基盤研究(C)	新規	一般科目	教授	吉塚 一典	マラソン練習を活用した登山事故対策の研究	H31-H34	1,400 (420)
若手研究	新規	電気電子工学科	講師	猪原 武士	ナノ秒パルスマイクロ放電の生成と水素製造技術への応用	H31-H32	2,100 (630)
若手研究	新規	電子制御工学科	講師	佐藤 直之	心理誘導と深層学習の2種類のアプローチによる対戦カードゲームAI	H31-H32	1,800 (540)
若手研究	継続	物質工学科	助教	森山 幸祐	組織損傷時の生体内環境に着想を得たエクソソーム生産用の幹細胞培養環境設計	H30-H31	1,500 (450)
基盤研究(A)	継続	校長	校長	東田 賢二	転位遮蔽理論に基づく水素脆化の階層的モデリングとその実験的検証	H30-H34	4,100 (1,230)
基盤研究(C)	継続	物質工学科	准教授	城野 祐生	マイクロ流動層の開発	H30-H32	1,400 (420)
基盤研究(C)	継続	電子制御工学科	准教授	手島 裕詞	深層学習を用いたコンシューマ向け3Dスキャナーデータの超解像技術の開発	H30-H32	500 (150)
基盤研究(C)	継続	機械工学科	准教授	松山 史憲	低炭素化浄化槽実現のためのマイクロバブルとプラズマの融合による促進酸化法の開発	H30-H32	1,600 (480)
若手研究(A)	継続	電子制御工学科	講師	横田 論	幾何学的な物体拘束を保証して作業の信頼性を高めるロボットマニピュレーション	H29-H31	2,200 (660)
基盤研究(C)	継続	電気電子工学科	准教授	大島 多美子	粉体ターゲットのコントロールによるスパッタリング成膜の高度化	H29-H31	500 (150)
基盤研究(C)	継続	機械工学科	准教授	森田 英俊	脆性材料内部で生成されるステルスき裂を利用した高速非接触ドライ切断技術の開発	H29-H31	1,200 (360)
基盤研究(C)	継続	電子制御工学科	准教授	坂口 彰浩	ダイヤモンドワイヤ製造工程における砥粒分散状態のオンマン計測	H29-H31	500 (150)
基盤研究(C)	継続	一般科目	准教授	真部 広紀	地球外の縦孔・地下空洞を含む洞窟地形の計測システムと3次元モデルの活用	H28-H31	研究期間延長

※直接経費(間接経費)については、当該年度の配分額を表す(平成31年4月1日現在)

○平成30年度

単位:千円

研究種目	新規/継続	学科	代表者名		研究課題名	研究期間	直接経費 (間接経費)
基盤研究(A)	新規	校長	校長	東田 賢二	転位遮蔽理論に基づく水素脆化の階層的モデリングとその実験的検証	H30-H34	16,700 (5,010)
基盤研究(C)	新規	物質工学科	准教授	城野 祐生	マイクロ流動層の開発	H30-H32	1,100 (330)
基盤研究(C)	新規	機械工学科	准教授	貞弘 晃宜	マルチセンサと確率共振を用いて計測した筋電位からの事前運動推定法の開発	H30-H32	1,000 (300)
基盤研究(C)	新規	電子制御工学科	准教授	手島 裕詞	深層学習を用いたコンシューマ向け3Dスキャナーデータの超解像技術の開発	H30-H32	2,500 (750)
基盤研究(C)	新規	機械工学科	准教授	松山 史憲	低炭素化浄化槽実現のためのマイクロバブルとプラズマの融合による促進酸化法の開発	H30-H32	1,500 (450)
若手研究(A)	継続	電子制御工学科	講師	横田 論	幾何学的な物体拘束を保証して作業の信頼性を高めるロボットマニピュレーション	H29-H31	2,700 (810)
基盤研究(C)	継続	電気電子工学科	准教授	大島 多美子	粉体ターゲットのコントロールによるスパッタリング成膜の高度化	H29-H31	600 (180)
基盤研究(C)	継続	機械工学科	准教授	森田 英俊	脆性材料内部で生成されるステルスき裂を利用した高速非接触ドライ切断技術の開発	H29-H31	1,200 (360)
基盤研究(C)	継続	電子制御工学科	准教授	坂口 彰浩	ダイヤモンドワイヤ製造工程における砥粒分散状態のオンマン計測	H29-H31	400 (120)
基盤研究(C)	継続	電気電子工学科	准教授	篠原 正典	プラズマ酸化反応の原子レベルでの制御法の開発研究	H28-H30	1,300 (390)
基盤研究(C)	継続	電気電子工学科	教授	川崎 仁晴	裏面照射粉体PLD法による3次元構造を持つ多層多元素薄膜の作製	H28-H30	700 (210)
基盤研究(C)	継続	一般科目	教授	松谷 茂樹	アーベル関数論の可積分系への応用	H28-H30	1,100 (330)
基盤研究(C)	継続	一般科目	准教授	真部 広紀	地球外の縦孔・地下空洞を含む洞窟地形の計測システムと3次元モデルの活用	H28-H30	100 (30)
基盤研究(C)	継続	物質工学科	教授	古川 信之	ネットワーク形成能を有する耐熱性オリゴマーの創製とポリマーアロイの応用技術開発	H28-H30	700 (210)

※直接経費(間接経費)については、当該年度の配分額を表す

○平成29年度

単位:千円

研究種目	新規/継続	学科	代表者名		研究課題名	研究期間	直接経費 (間接経費)
若手研究(A)	新規	電子制御工学科	講師	横田 諭	幾何学的な物体拘束を保証して作業の信頼性を高めるロボットマニピュレーション	H29-H31	7,400 (2,220)
基盤研究(C)	新規	電気電子工学科	准教授	大島 多美子	粉体ターゲットのコントロールによるスパッタリング成膜の高度化	H29-H31	2,600 (780)
基盤研究(C)	新規	機械工学科	准教授	森田 英俊	脆性材料内部で生成されるステルスき裂を利用した高速非接触ドライ切断技術の開発	H29-H31	1,300 (390)
基盤研究(C)	新規	電子制御工学科	准教授	坂口 彰浩	ダイヤモンドワイヤ製造工程における砥粒分散状態のオンマシン計測	H29-H31	2,900 (870)
基盤研究(C)	継続	電気電子工学科	准教授	篠原 正典	プラズマ酸化反応の原子レベルでの制御法の開発研究	H28-H30	1,200 (360)
基盤研究(C)	継続	電気電子工学科	教授	川崎 仁晴	裏面照射粉体PLD法による3次元構造を持つ多層多元素薄膜の作製	H28-H30	1,000 (300)
基盤研究(C)	継続	一般科目	教授	松谷 茂樹	アーベル関数論の可積分系への応用	H28-H30	1,100 (330)
基盤研究(C)	継続	一般科目	准教授	真部 広紀	地球外の縦孔・地下空洞を含む洞窟地形の計測システムと3次元モデルの活用	H28-H30	100 (30)
基盤研究(C)	継続	物質工学科	教授	古川 信之	ネットワーク形成能を有する耐熱性オリゴマーの創製とポリマーアロイの応用技術開発	H28-H30	1,100 (330)
研究活動スタート支援	継続	一般科目	講師	大浦 龍二	リフティングウェーブレット変換に基づくコンテンツの真正性を保証する電子透かし法	H28-H29	1,100 (330)
基盤研究(C)	継続	電子制御工学科	教授	志久 修	曲がった文字列も対応可能な実環境文字列認識方法の開発	H27-H29	1,100 (330)
基盤研究(C)	継続	電子制御工学科	教授	川下 智幸	非可視光線を用いた画像処理によるダイヤモンド砥石の砥粒分散の解析に関する研究	H27-H29	200 (60)
挑戦的萌芽研究	継続	電子制御工学科	講師	横田 諭	手指の筋腱複合体の弾性特性に着目した物体操作運動の解析とスポーツ指導への展開	H27-H29	研究期間延長
基盤研究(A)	継続		校長	東田 賢二	超顕微材料科学とマイクロ・フラクチャーメカニクスの融合による破壊靱性研究の革新	H26-H29	4,300 (1,290)
基盤研究(C)	継続	機械工学科	教授	中島 賢治	ラグビー選手のコンタクトフィットネス負荷を計測するシステムの開発	H26-H29	研究期間延長

※直接経費(間接経費)については、当該年度の配分額を表す

○平成28年度

単位:千円

研究種目	新規/継続	学科	代表者名		研究課題名	研究期間	直接経費 (間接経費)
基盤研究(C)	新規	電気電子工学科	教授	川崎 仁晴	裏面照射粉体PLD法による3次元構造を持つ多層多元素薄膜の作製	H28-H30	1,900 (570)
基盤研究(C)	新規	一般科目	教授	松谷 茂樹	アーベル関数論の可積分系への応用	H28-H30	1,300 (390)
基盤研究(C)	新規	一般科目	准教授	真部 広紀	地球外の縦孔・地下空洞を含む洞窟地形の計測システムと3次元モデルの活用	H28-H30	3,000 (900)
基盤研究(C)	新規	物質工学科	教授	古川 信之	ネットワーク形成能を有する耐熱性オリゴマーの創製とポリマーアロイの応用技術開発	H28-H30	1,800 (540)
研究活動スタート支援	新規	一般科目	講師	大浦 龍二	リフティングウェーブレット変換に基づくコンテンツの真正性を保証する電子透かし法	H28-H29	1,200 (360)
基盤研究(C)	継続	電子制御工学科	教授	志久 修	曲がった文字列も対応可能な実環境文字列認識方法の開発	H27-H29	1,100 (330)
基盤研究(C)	継続	電子制御工学科	教授	川下 智幸	非可視光線を用いた画像処理によるダイヤモンド砥石の砥粒分散の解析に関する研究	H27-H29	1,200 (360)
若手研究(B)	継続	電気電子工学科	准教授	大島 多美子	ターゲットに粉体を用いたスパッタリング成膜とそのプロセスプラズマ反応機構解明	H27-H28	600 (180)
若手研究(B)	継続	電気電子工学科	助教	猪原 武士	ナノ秒パルス放電プラズマによる超小型水素製造装置の開発	H27-H28	1,200 (360)
挑戦的萌芽研究	継続	電子制御工学科	講師	横田 諭	手指の筋腱複合体の弾性特性に着目した物体操作運動の解析とスポーツ指導への展開	H27-H28	700 (210)
基盤研究(A)	継続		校長	東田 賢二	超顕微材料科学とマイクロ・フラクチャーメカニクスの融合による破壊靱性研究の革新	H26-H29	4,800 (1,440)
基盤研究(C)	継続	機械工学科	教授	中島 賢治	ラグビー選手のコンタクトフィットネス負荷を計測するシステムの開発	H26-H28	1,400 (420)
基盤研究(C)	継続	機械工学科	准教授	森田 英俊	レーザーによる急加熱部近傍で発生する引張応力を利用した脆性材料の新しい除去加工技術	H26-H28	1,400 (420)
基盤研究(C)	継続	一般科目	准教授	真部 広紀	水没によって閉鎖された空間環境を探索する水中・非水中複合ロボットシステム	H25-H28	研究期間延長

※直接経費(間接経費)については、当該年度の配分額を表す

○平成27年度

単位:千円

研究種目	新規/継続	学科	代表者名		研究課題名	研究期間	直接経費 (間接経費)
基盤研究(C)	新規		校長	中尾 充宏	無限次元非線形数値モデルに対する高精度数値的検証理論の構築	H27-H29	1,500 (450)
基盤研究(C)	新規	電子制御工学科	教授	志久 修	曲がった文字列も対応可能な実環境文字列認識方法の開発	H27-H29	1,400 (420)
基盤研究(C)	新規	電子制御工学科	教授	川下 智幸	非可視光線を用いた画像処理によるダイヤモンド砥石の砥粒分散の解析に関する研究	H27-H29	2,300 (690)
若手研究(B)	新規	電気電子工学科	准教授	大島 多美子	ターゲットに粉体を用いたスパッタリング成膜とそのプロセスプラズマ反応機構解明	H27-H28	2,500 (750)
若手研究(B)	新規	電気電子工学科	助教	猪原 武士	ナノ秒パルス放電プラズマによる超小型水素製造装置の開発	H27-H28	2,000 (600)
若手研究(B)	新規	一般科目	講師	生住 昌大	明治期<文芸メディア>研究基盤構築のための錦絵データベースの作成	H27-H30	1,100 (330)
挑戦的萌芽研究	新規	電子制御工学科	講師	横田 諭	手指の筋腱複合体の弾性特性に着目した物体操作運動の解析とスポーツ指導への展開	H27-H28	2,000 (600)
基盤研究(C)	継続	機械工学科	教授	中島 賢治	ラグビー選手のコンタクトフィットネス負荷を計測するシステムの開発	H26-H28	他機関出向
基盤研究(C)	継続	機械工学科	准教授	森田 英俊	レーザーによる急加熱部近傍で発生する引張応力を利用した脆性材料の新しい除去加工技術	H26-H28	1,100 (330)
基盤研究(C)	継続	電気電子工学科	教授	須田 義昭	裏面照射粉体PLD法による薄膜作成プロセスの開発	H26-H28	1,100 (330)
基盤研究(C)	継続	電子制御工学科	教授	重松 利信	太陽光発電施設のフィールド調査および日本全土を網羅する観測システムの構築	H25-H27	200 (60)
基盤研究(C)	継続	物質工学科	教授	古川 信之	アロイ化による新規な耐熱性高分子複合材料の創製と応用技術開発	H25-H27	1,300 (390)
基盤研究(C)	継続	一般科目	准教授	真部 広紀	水没によって閉鎖された空間環境を探索する水中・非水中複合ロボットシステム	H25-H27	200 (60)
基盤研究(C)	継続	一般科目	准教授	吉塚 一典	熱中症防止のための体温コントロールに関する研究	H24-H27	研究期間延長

※直接経費(間接経費)については、当該年度の配分額を表す